

无需复杂方案的 600V 高端开关：隆重推出我们的 P 沟道 MOSFET 系列

在 600V 系统中进行高端开关设计，往往伴随着额外的复杂性。

当使用 N 沟道 MOSFET 时，通常需要引入自举电路、充电泵、浮地栅极驱动器以及精细的时序控制，这不仅增加了成本，也提高了设计风险和验证工作量。

为了解决这些挑战，Analog Power Inc. 推出了 600V P 沟道 MOSFET 系列，为工程师提供一种更简单、更安全、更易控制的高压高端开关解决方案。

为什么在 600V 应用中选择 P 沟道？

在高压应用中，简洁性与可靠性往往比极致效率更重要。

P 沟道 MOSFET 在高侧配置中具备多项先天优势：

- 直接、参考地的栅极驱动

P 沟道器件只需将栅极拉低即可导通，无需自举电路、充电泵或隔离驱动器。

- 具备失效安全特性的高端行为

在上电或故障状态下，预设保持关闭状态，可有效降低误导通风险，提升系统安全性。

- 更低的系统级复杂度

更少的外围器件、更简化的 PCB 布局以及更容易控制的 EMI，使设计周期更短，系统性能更可预测。

对于许多 600V 系统，尤其是辅助电源轨、保护通路以及工业控制电路，P 沟道 MOSFET 往往是更具工程实用性的选择。

典型应用：

- 高压系统中的高端开关
- 脱机式 SMPS 辅助电源电路
- 工业电源控制与负载开关
- 负载断开与保护通路
- 高压电源管理系统

Analog Power Inc. 提供多种封装选择

为满足不同设计需求，Analog Power Inc. 为该 600V P 沟道 MOSFET 系列提供多种行业标准封装，说明工程师在散热性能、功率密度和 PCB 占板面积之间灵活取舍：

- TO-220
- TO-220F
- TO-247
- TO-262
- TO-263-3
- TO-263-6L
- TO-252 (DPAK)
- DFN 5×6 EP
- DFN 3×3 EP

同时支持直插式与贴片式封装，适用于工业、电源管理以及紧凑型系统设计。

现已量产并提供数据手册的产品包括：

AM10P60-800D <https://www.analogpowerinc.com/products/AM10P60-8000D>

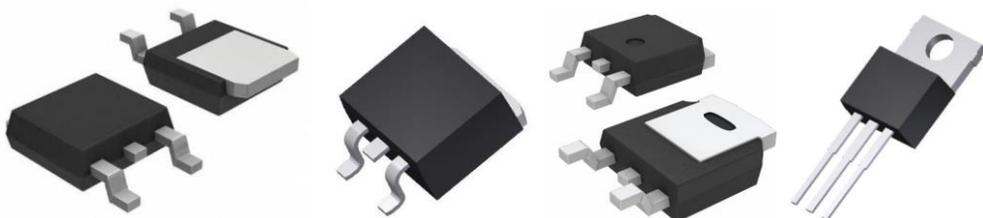
AM10P60-800PF <https://www.analogpowerinc.com/products/AM10P60-8000PF>

AMRM03P <https://www.analogpowerinc.com/products/AMRM03P>

AMSM05P <https://www.analogpowerinc.com/products/AMSM05P>

AM10P60-800P <https://www.analogpowerinc.com/products/AM10P60-8000P>

可根据需求提供样品及批量供货。





600V P 沟道，真正做到位
Analog Power Inc.

如需了解更多信息，请访问 www.analogpowerinc.com.

关于 Analog Power

Analog Power 成立于 2002 年，总部位于美国加州圣何塞，是一家专注于功率 MOSFET 的领先制造商。公司产品涵盖 20V 至 1500V 的 N 沟道与 P 沟道 MOSFET，同时提供多种应用专用型 MOSFET，助力客户实现更小体积、更高性能的终端产品。

Analog Power 采用一线晶圆代工厂，并结合专业的封装与测试外包服务，在确保市场领先质量与可靠性的同时，始终保持灵活、高效、以客户为中心的运营模式。

联系方式

Analog Power Inc.

台北市内湖区洲子街 58 号 A7 1F

邮编：114064

<https://www.analogpowerinc.com/contactus.html>